

# Теоретико-множественное представление сложно-функциональных блоков в системе автоматизированного проектирования интегральных

# схем на основе реконфигурируемых систем на кристалле

# В. М. Хватов

#### Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН, Москва

В Аннотация: статье представлена программно-ориентированная теоретикомножественная модель сложно-функциональных блоков (СФ-блоков) реконфигурируемой системы на кристалле (РСнК), позволяющая ввести их в систему автоматизированного проектирования (САПР) на разных этапах проектирования интегральной схемы на основе РСнК и выполнить отображение архитектурно-независимых СФ-блоков проектируемой схемы в СФ-блоки базового кристалла. Модель объединяет в себе формализованные базового кристалла, архитектурно-независимых представления компонентов И архитектурно-зависимых параметризованных СФ-блоков для этапа логического синтеза, а также СФ-блоков для этапа топологического синтеза. Также модель имеет несколько отличительных особенностей. Первой особенностью является наличие относительных координат элементов гибких СФ-блоков, что позволяет учесть архитектурные особенности РСнК на этапе размещения. Вторая особенность - информация о специализированных трассировочных ресурсах и межсоединениях проектируемой и базовой схем, что дает возможность установить соответствие между соединениями СФблока и РСнК независимо от типов трассировочных ресурсов.

**Ключевые слова:** реконфигурируемая система на кристалле, сложно-функциональный блок, программируемая логическая интегральная схема, система автоматизированного проектирования, теоретико-множественная модель, формализация.

#### Введение

В настоящее время широкое применение получают отечественные реконфигурируемые системы на кристалле (РСнК). Они, как правило, состоят из набора заказных жестких сложно-функциональных блоков (СФ-блоков) и программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС) [1].

Жёсткими СФ-блоками из базиса РСнК являются блоки, имеющие заранее определённые позиции на кристалле, и выполняющие ряд логических функций, определяющих режимы работы блока. Программирование требуемого режима работы жестких СФ-блоков, в зависимости от архитектуры, может выполняться статически, за счет подачи сигналов из



конфигурационной памяти на управляющие контакты, или динамически, за счет передачи данных на информационные контакты [2].

Другая составная часть РСнК – ПЛИС – представляет собой регулярную матрицу конфигурируемых логических блоков (ЛБ) и множество коммутационных элементов, обеспечивающих соединения между ними [3,4]. Стандартные ячейки, являющиеся запрограммированными ЛБ ПЛИС, в совокупности с жёсткими СФ-блоками представляют библиотечный базис РСнК, который является основой для проектируемой схемы. Базис может быть расширен за счет добавления гибких СФ-блоков блоков, которые, в отличие от жестких, состоят из ЛБ, не имеют заранее известной позиции на кристалле И сконфигурированных межсоединений [5]. Для более эффективного результата логического и физического синтеза данного типа СФ-блоков в архитектуре ПЛИС содержатся специализированные ресурсы, позволяющие повысить частоту их работы, а также сократить количество используемых ЛБ и коммутационных элементов [6].

Все особенности жестких и гибких СФ-блоков необходимо учесть при их интеграции в систему автоматизированного проектирования (САПР) интегральных схем (ИС) на основе базовой РСнК. Для этого необходим программно-ориентированный математический аппарат

Существующие модели, используемые в САПР зарубежных производителей [7,8] и в методах для выполнения определенных этапов проектирования, либо разработаны под конкретную технологию или архитектуру [9,10] и не применимы к новым РСнК, либо не содержат требуемой информации, которая позволила бы управлять архитектурными особенностями и специализированными ресурсами базовой схемы [11,12].

В связи с этим, была разработана обобщенная теоретикомножественная модель параметризованных программируемых СФ-блоков, ориентированная на практическое применение в САПР. Она объединяет в



себе представление СФ-блоков из базовой схемы, разрабатываемой схемы и из библиотек САПР для различных этапов маршрута проектирования.

### Основные составляющие теоретико-множественной модели СФ-блоков

В состав разработанной модели входит ряд основных множеств СФблоков:

1) *Y* – множество архитектурно-независимых логических элементов и параметризованных СФ-блоков из библиотеки для логического синтеза;

*T* – вспомогательное множество параметризованных СФ-блоков для технологического отображения архитектурно-независимых СФ-блоков проектируемой схемы в архитектурно-зависимые;

3) *В* – множество параметризованных СФ-блоков для топологического синтеза и отображения архитектурно-зависимых блоков в подсхемы целевого кристалла.

На основе представленных множеств СФ-блоков введены следующие представления проектируемой схемы:

1)  $c_y$  – схема после архитектурно-независимого логического синтеза,

*c<sub>t</sub>* – схема после логического синтеза и до технологического отображения архитектурно-независимых СФ-блоков в архитектурно-зависимые,

 с<sub>b</sub> – схема после отображения архитектурно-независимых СФблоков схемы в архитектурно-зависимые.

# Формализованное представление базовой РСнК

Все подсхемы, составляющие базовую РСнК в схемотехническом описании представлены множеством *С*. Из данного множества выделены подсхемы, участвующие в процессе проектирования разрабатываемой схемы: *С*<sub>*LE*</sub> – логические блоки, *С*<sub>*IO*</sub> – ячейки ввода/вывода, *С*<sub>*M*</sub> – жесткие СФ-блоки,



 $C_{RT}$  – трассировочные элементы и  $c_f$  – подсхема верхнего уровня:  $C = \{C_{LE} \cup C_{IO} \cup C_M \cup C_{RT} \cup c_f\}.$ 

Подсхема верхнего уровня  $c_f$  характеризуется следующими структурными компонентами:  $c_f = (\mu(c_f), E(c_f), P(c_f), N(c_f))$ , где  $\mu(c_f) - имя$  подсхемы,  $E(c_f) = \{e_f\} - элементы подсхемы; <math>P(c_f) = \{p_f\} - внешние контакты; N(c_f) = \{n_f\} - межсоединения. На основе того, что внутреннее содержимое подсхем <math>C_{LE} \cup C_{IO} \cup C_M \cup C_{RT}$  скрыто от внешнего пользователя, они представлены исключительно именем и внешними контактами.

Элементы  $c_f$  характеризуются следующими компонентами:  $\forall e_f \in E(c_f)$ :  $e_f = (\mu(e_f), m_c(e_f), P(e_f), r(e_f))$ , где  $\mu(e_f)$  – имя элемента;  $m_c(e_f) \in C / c_f$  – модель элемента базовой РСнК;  $P(e_f) = \{p_x\}$  – множество контактов элемента;  $r(e_f)$  – координаты ЛБ. Если  $m_c(e_f) \in C_{LE}$ , то  $r(e_f) \neq \emptyset$ .

Контакты элемента  $e_f$  представлены следующими компонентами:  $\forall p_x \in$  $P(e_f): p_x = (\mu(p_x), d(p_x), f(p_x)),$  где  $\mu(p_x) -$ имя контакта,  $d(p_x) \in \{d_{inp}, d_{out}, d_{inout}\}$ направление контакта: входной, выходной или двунаправленный,  $f(p_x) \in \{f_{rstd}, f(p_x)\}$ frsp.  $f_m$ функциональное контакта: стандартный назначение коммутационный, специальный коммутационный или конфигурационный. В соответствии с назначением можно выделить следующие типы контактов: конфигурационные  $P_m(e_f)$ , необходимые для выбора режима подсхемы; коммутационные стандартные  $P_{rstd}(e_f)$ , подключенные к трассировочным ресурсам общего назначения и предназначенные для конфигурирования подсхем под стандартный элемент библиотеки логических элементов; коммутационные специализированные  $P_{rsp}(e_f)$ , подключенные К трассировочным ресурсам специального назначения, позволяющим снизить количество ЛЭ в схеме, увеличить её быстродействие и снизить объем занятых трассировочных ресурсов. Последний тип контактов предназначен для конфигурирования подсхем под библиотечные элементы, требуемые для



проектирования гибких СФ-блоков. Первый и второй типы контактов входят в состав подсхем *С* / *c<sub>f</sub>*, третий тип входит только в состав ЛБ.

Началом отсчета координат  $r(e_f)$  элементов регулярной матрицы ПЛИС в РСнК выбран левый нижний ЛБ. Координаты состоят из номера строки и столбца ЛБ в РСнК: если  $e_f \in E(c_f)$ ,  $m_c(e_f) \in C_{LE}$ , то  $r(e_f) = (r_l, r_c)$ , где  $r_l$  – номер строки,  $r_c$  – номер столбца матрицы ЛБ РСнК,  $r_l = 1, ..., M_l$ ,  $r_c = 1, ..., M_c$ , где  $M_l$  – число строк,  $M_c$  – число столбцов ЛБ в РСнК. Информация о координатах не задана в схемотехническом описании, но присутствует в графическом представлении РСнК или её топологии.

Межсоединения подсхемы  $c_f$  представлены следующими составляющими:  $\forall n_f \in N(c_f)$ :  $n_f = (\mu(n_f), p_x^{s}(n_f), \{p_x^{d}(n_f)\})$ , где  $\mu(n_f) - имя$  межсоединения,  $p_x^{s}(n_f) -$ контакт типа «источник», являющийся выходом элемента подсхемы,  $\{p_x^{d}(n_f)\} -$ множество контактов типа «приемник», являющихся входами подсхемы. Если  $p_x^{s}(n_f)$  и  $n_f \in N(c_f)$ , то  $d(p_x^{s}) = d_{out} | d_{inout}$ , если  $p_x^{d}(n_f)$  и  $n_f \in N(c_f)$ , то  $d(p_x^{d}) = d_{in} / d_{inout}$ .

#### Формализованное представление проектируемой схемы

Множество логических элементов и СФ-блоков внутренней библиотеке программы для логического синтеза, не зависящих от архитектуры целевого обозначено через *Y*. Элементы кристалла, данного множества характеризуются следующими компонентами:  $\forall y \in Y$ :  $y = (\mu(y), \tau(y), \tau(y),$ P(y), O(y)), где  $\mu(y)$  – имя библиотечного элемента  $y, \tau(y)$  – тип элемента,  $\tau(y)$ – подтип элемента,  $\tau(y) \in \{\tau_{le}, \tau_{macro}\}$ , где  $\tau_{le}$  – стандартный комбинационной элемент или триггер,  $\tau_{macro}$  – СФ-блок; O(y) – параметры элемента, P(y) – внешние контакты. На основе типа элемента формируются следующие подмножества:  $Y = Y_{le} \cup Y_{macro}$ . При этом, если  $\tau(y) = \tau_{macro}$ , то  $y \in Y_{macro}$ . Подтип СФ-блока определяется в соответствии с его функциональным назначением. Например, в состав РСнК и ПЛИС могут входить СФ-блоки



следующих подтипов: умножители ( $\tau_{mul}$ ), сумматоры ( $\tau_{add}$ ), многоразрядные счётчики ( $\tau_{cnt}$ ), блоки памяти ( $\tau_{ram}$ ), процессоры обработки сигналов ( $\tau_{dsp}$ ). В соответствии с этим, если элемент имеет тип  $\tau(y) = \tau_{macro}$ , то  $\tau(y) \in \{\tau_{mul}, \tau_{add}, \tau_{cnt}, \tau_{ram}, \tau_{dsp}\}$ . Если тип элемента  $\tau(y) = \tau_{le}$ , то элемент может быть комбинационным элементом ( $\tau_{comb}$ ) или триггером ( $\tau_{dff}$ ):  $\tau(y) \in \{\tau_{comb}, \tau_{dff}\}$ .

Параметры библиотечного элемента O(y) необходимы для технологического отображения элемента внутренней архитектурнонезависимой библиотеки в требуемый элемент, учитывающий архитектуру РСнК. Параметры O(y) представлены следующими компонентами:  $\forall o \in O(y)$ :  $o = (\mu(o), \Upsilon(o))$ , где  $\mu(o)$  – имя параметра,  $\Upsilon(o) = \{v\}$  – его значения.

Проектируемая схема после логического И синтеза ДО технологического отображения обозначена через су и является списком соединений без иерархии, который можно описать компонентами, аналогичными  $c_f$ :  $c_v = (\mu(c_v), E(c_v), P(c_v), N(c_v))$ . Отличие заключается в представлении элементов схемы  $E(c_y)$ :  $\forall e_y \in E(c_y)$ :  $e_y = (\mu(e_y), m_y(e_y), O(e_y),$  $P(e_v)$ ). Модель элементов  $m_v(e_v) \in Y$ . Элементы в  $c_v$ , в отличие от  $c_f$ , не имеют координат, но имеют параметры, заданные после логического синтеза:  $O(e_v)$  $= \{o\}.$ 

Параметры элемента  $O(e_y)$  представлены парой компонентов:  $\forall o \in O(e_y)$ :  $o = (\mu(o), v(o))$ , где  $\mu(o) - имя$  параметра,  $v(o) - заданное значение параметра. Контакты элемента <math>\forall p_z \in P(e_y)$  и контакты проектируемой схемы  $\forall p_y \in P(c_y)$  представлены компонентами, аналогичными компонентам контактов  $P(c_f)$ . Межсоединения проектируемой схемы  $\forall n_y \in N(c_y)$ : представлены компонентами, аналогичными компонентам  $c_f$ .

Отображение СФ-блока из архитектурно-независимой библиотеки в СФ-блок РСнК имеет следующий вид:  $\{m_y(e_y): m_y(e_y) \in Y, e_y \in E(c_y)\} \rightarrow$ 



 $\{m_c(e_f): m_c(e_f) \in C, e_f \in E(c_f)\}$ . Компоненты представленной модели позволяют выполнить отображение в три этапа:

1) отображение архитектурно-независимых моделей СФ-блоков проектируемой схемы из Y в модели из вспомогательной библиотеки для технологического отображения  $T: \{m_y(e_y): m_y(e_y) \in Y, e_y \in E(c_y)\} \rightarrow \{m_t(e_t): m_t(e_t) \in T, e_t \in E(c_t)\};$ 

2) отображение моделей полученных СФ-блоков в архитектурнозависимые модели из библиотеки для физического синтеза B: { $m_t(e_t)$ :  $m_t(e_t) \in T$ ,  $e_t \in E(c_t)$ } → { $m_b(e_b)$ :  $m_b(e_b) \in B$ ,  $e_b \in E(c_b)$ };

3) отображение в модели СФ-блоков из РСнК:  $\{m_b(e_b): m_b(e_b) \in B, e_b \in E(c_b)\}$  →  $\{m_c(e_f): m_c(e_f) \in C, e_f \in E(c_f)\}$ .

Схемы  $c_t$  и  $c_b$  характеризуется компонентами, которые аналогичны составляющим схемы  $c_y$ .

# Формализованное представление СФ-блоков из библиотеки для технологического отображения

СФ-блок из множества *T* представлен в модели следующими компонентами:  $\forall t \in T$ :  $t = (\mu(t), \tau^{(t)}, O(t), P(t), U(t), N(t))$ , где  $\mu(t) - имя$  СФблока, совпадающее с именем СФ-блока  $y \in Y$ : если  $t \in T$ ,  $y \in Y_{macro}$  и  $\tau^{(t)} = \tau^{(y)}$ , то  $\mu(t) = \mu(y)$ ;  $\tau^{(t)} - подтип$  СФ-блока.  $O(t) = \{o_t\} - параметры$  СФ-блока идентичные параметрам  $O(y), y \in Y_{macro}$ ;  $P(t) = \{p_t\} -$  внешние контакты;  $U(t) = \{u_t\} -$  варианты отображения СФ-блока;  $N(t) = \{n_t\} -$  межсоединения.

Контакты СФ-блока P(t) характеризуются именем и направлением. При этом, если  $t, y, t \in T, y \in Y_{macro}, \hat{\tau}(t) = \hat{\tau}(y)$ , то  $P(t) \Leftrightarrow P(y)$ .

Варианты отображения СФ-блока *t* представлены следующими компонентами:  $\forall u_t \in U(t)$ :  $u_t = (m_b(u_t), O(u_t), P(u_t))$ , где  $m_b(u_t) \in B$  – модель элемента из множества СФ-блоков для физического синтеза,  $O(u_t)$  – параметры для технологического отображения,  $P(u_t)$  – контакты элемента.



Если параметризованная модель элемента СФ-блока  $m_b(u_t) \in B$  не имеет фиксированных параметров,  $O(m(u_t)) \Leftrightarrow O(t), t \in T$ , то множество U(t)содержит один элемент: |U(t)| = |E(t)| = 1. Если модель имеет фиксированные параметры, то количество вариантов зависит от количества и значений параметров:

$$|U(t)| = \prod_{i=1}^{|O(t)|} |\Upsilon(o_i)|, o_i \in O(t), i = 1, ..., |O(t)|$$

Межсоединения СФ-блока *t* характеризуются следующими компонентами:  $\forall n_t \in N(t)$ :  $n_t = (\mu(n_t), \{p_t^s(n_t)\}, \{p_t^d(n_t)\})$ , где  $\mu(n_t) - имя$  межсоединения,  $\{p_t^s(n_t)\} -$ множество контактов типа «источник»,  $\{p_t^d(n_t)\} -$ множество контактов типа «источник»,  $\{p_t^d(n_t)\} -$ множество контактов типа «приемник».

На первом этапе архитектурно-зависимого отображения СФ-блоков выполняется отображение  $m_y(e_y) \in Y$  из схемы  $c_y$  в  $m_t(e_t) \in T$  схемы  $c_t$ . На втором этапе модель СФ-блока из множества  $m_t(e_t) \in T$  схемы  $c_t$ отображается в модель из библиотеки для физического синтеза *B*.

Для отображения СФ-блоков из схемы  $c_b$  в СФ-блоки РСнК разработано формализованное представление СФ-блоков в библиотеке для топологического синтеза, включающее топологическую информацию о СФ-блоке и его архитектурных особенностях.

# Формализованное представление СФ-блоков из библиотеки для топологического синтеза

Множество СФ-блоков для физического синтеза состоит из двух подмножеств:  $B = S \cup H$ , где  $S = \{s\}$  – множество гибких СФ-блоков;  $H = \{h\}$  – множество жестких СФ-блоков.

Множество жестких СФ-блоков представлено следующими компонентами:  $\forall h \in H$ :  $h = (\mu(h), m_c(h), P(h))$ , где  $\mu(h) - имя$  СФ-блока,  $m_c(h)$  $\in C_M$  – модель жёсткого СФ-блока, из схемотехнического описания РСнК,  $P(h) = \{p_h\}$  – контакты СФ-блока. Количество контактов жесткого СФ-блока,



их направление и функциональное назначение совпадает с контактами подсхемы  $P(c), c \in C_M$ .

Гибкий СФ-блок представлен следующими компонентами:  $\forall s \in S$ :  $s = (\mu(s), O(s), P(s), E(s), N(s))$ , где  $\mu(s)$  –имя СФ-блока;  $O(s) = \{o_s\}$  – параметры СФ-блока;  $P(s) = \{p_s\}$  – внешние контакты;  $E(s) = \{e_s\}$  – элементы в составе гибкого СФ-блока;  $N(s) = \{n_s\}$  – межсоединения.

множества Элементы E(s)характеризуются компонентами, аналогичными компонентам ЛБ подсхемы  $c_t$ :  $\forall e_s \in E(s)$ :  $e_s = (\mu(e_s), m_l(e_s),$  $P(e_s)$ ,  $r(e_s)$ ), где  $\mu(e_s)$  – имя элемента;  $m_l(e_s) \in L_{LE}$  – модель элемента, представленная в библиотеке ЛЭ;  $P(e_s) = \{p_a\}$  – контакты элемента, которые полностью повторяют контакты частично ИЛИ модели, a также характеризуются введённым для неё набором компонентов;  $r(e_s)$  – относительные координаты элементов гибкого СФ-блока.

Элементы библиотеки ЛЭ  $\forall l \in L_{LE}$  получены с помощью программирования ЛБ РСнК под определённую функцию. Они характеризуются именем, моделью –  $m_c(l) \in C_{LE}$  и внешними контактами, имеющими направление и функциональное назначение контактов подсхемы  $c \in C_{LE}$ .

Относительные координаты элементов гибкого СФ-блока представляют собой пару компонентов:  $r(e_s) = (r_l, r_c)$ , где  $r_l$  – номер строки,  $r_c$  – номер столбца элемента в СФ-блоке:  $r_l = 1, ..., I_{max}, r_c = 1, ..., J_{max}$ , где  $I_{max}$  – максимальный номер строки элементов и  $J_{max}$  – максимальный номер строки элементов и  $J_{max}$  – максимальный номер столбца, не превышающие количество строк и столбцов РСнК. Они позволяют разместить элементы гибкого СФ-блока относительно друг друга. Началом отсчета координат является левый нижний угол СФ-блока.

Межсоединения гибкого СФ-блока представлены следующими компонентами:  $\forall n_s \in N(s)$ :  $n_s = (\mu(n_s), p_q^s(n_s), \{p_q^d(n_s)\}, v_s^s(n_s), \{v_s^d(n_s)\})$ , где  $\mu(n_s)$  – имя меж-соединения,  $p_q^s(n_s)$  – контакт типа «источник»,  $\{p_q^d(n_s)\}$  –



множество контактов типа «приемник»,  $v_s^{s}(n_s)$  – узел РСнК, соответствующий межсоединению разрабатываемой схемы, типа «источник»,  $\{v_s^{d}(n_s)\}$  – множество узлов РСнК типа «приемник». При этом, если  $\forall p_q \in p_q^{s}(n_s) \cup \{p_q^{d}(n_s)\}$  и  $n_s \in N(s)$ , то  $p_q \in \bigcup_{i=1}^{|E(s)|} P(e_s^{i}) \cup P(s)$ .

Подключение межсоединений к специализированным контактам ЛБ РСнК возможно только после корректного размещения элементов СФ-блока  $s \in S$  друг относительно друга и трассировке его межсоединений через специализированные ресурсы. Корректное размещение элементов СФ-блока достигается за счет относительных координат, введенных в модели, трассировка через специализированные ресурсы – за счет компонентов межсоединений, позволяющих установить соответствие между соединениями СФ-блока и РСнК.

Пусть проектируемая схема  $c_b$  и составляющие её гибкие СФ-блоки представлены в плоском виде. Тогда размещение элементов схемы – это процесс, в ходе которого каждому её элементу ставится в соответствие элемент РСнК:  $E(c_b) \rightarrow \{e_f: e_f \in E(c_f)\}$ . При этом относительные координаты элементов СФ-блока учитываются следующим образом:

если 
$$e_b^{\ i}, e_f^{\ j}, e_b^{\ i} \in E(c_b), e_f^{\ j} \in E(c_f), m_b(e_b^{\ i}) \in L_{LE}, m_c(e_f^{\ j}) \in C_{LE}$$
  
 $i = 1, \dots, |E(s)|, j = 1, \dots, |E(c_f)|,$  то  
 $(r_l(e_b^{\ i}), r_c(e_b^{\ i})) \rightarrow (r_l(e_f^{\ j}) + r_l(e_b^{\ i}), r_c(e_f^{\ j}) + r_c(e_b^{\ i})).$ 

Чтобы гарантировать использование специализированных трассировочных ресурсов РСнК в СФ-блоке, используется точечная трассировка. Для определения понятия точечной трассировки в САПР задан трассировочный граф: G = (V, A). Вершины V являются узлами РСнК:  $\forall v_g \in$ V:  $v_g = (n_v(v_g), d_v(v_g)), n_v(v_g) \in N(c_f)$ , где  $n_v(v_g)$  – межсоединение РСнК, соответствующее вершине,  $d_v(v_g)$  – направление вершины (направленная



прямая, направленная инверсная, двунаправленная). Ребра графа  $A = \{a_g\}$  являются упорядоченной парой вершин  $A \subseteq \{v_g^{\ s}, v_g^{\ d} \mid v_g^{\ s}, v_g^{\ d} \in V \& v_g^{\ s} \neq v_g^{\ d}\}.$ 

С учетом вышесказанного, точечная трассировка – это установление соответствия между межсоединением СФ-блока и одним узлом или одним ребром графа трассировки. Для её реализации введены несколько подходов. Первый подход осуществляет точечную трассировку с помощью заданного межсоединения СФ-блока *net*, соответствующего ему ребра трассировочного графа  $a_g = (node0, node1)$  и направления узла приемника d(node1): если  $n_s =$ *net*, *net*  $\in N(s)$ , то  $v_s^s(n_s) = v_g^s(n_s)$ ,  $v_s^d(n_s) = v_g^d$ ,  $v_g^s = node0$ ,  $v_g^d = node1$ ,  $d(v_g^d) =$ d(node1),  $d(node1) \in \{d_{dir}, d_{inv}, d_{bidir}\}$ .

Второй подход осуществляет точечную трассировку с помощью межсоединения проектируемой схемы *net*, соответствующего ему узла РСнК *node0* и направления узла d(node0): если  $n_s = net$ ,  $net \in N(s)$ , то  $v_s^d(n_s) = v_g^d$ ,  $v_s^d(n_s) \in \{v_s^d(n_s)\}, v_g^d = node0, d(node0) \in \{d_{dir}, d_{inv}, d_{bidir}\}.$ 

#### Заключение

В данной работе представлена обобщенная модель жёстких и гибких сложно-функциональных блоков, позволяющая выполнить отображение архитектурно-независимых блоков из списка соединений проектируемой схемы в СФ-блоки, входящие в состав РСнК. Модель объединяет в себе ряд множеств СФ-блоков на различных этапах маршрута проектирования ИС на основе РСнК: параметризованные архитектурно-независимые СФ-блоки для логического синтеза, вспомогательные архитектурно-зависимые СФ-блоки для технологического отображения и архитектурно-зависимые СФ-блоки для отображения РСнК. топологического синтеза И В компоненты Формализованное представление СФ-блоков из последнего множества также включает в себя компоненты, позволяющие выполнить размещение и



трассировку СФ-блоков с учетом специализированных коммутационных ресурсов и нестандартных решений и особенностей архитектуры РСнК.

Также модель, представленная в статье, кроме СФ-блоков, включает в себя формализованное представление базового кристалла и проектируемой схемы, формирующейся в процессе генерации СФ-блоков из базиса РСнК, выполняющейся на основе архитектурно-независимых СФ-блоков.

### Литература

- Заплетина М.А., Железников Д.А., Гаврилов С.В. Иерархический подход к трассировке реконфигурируемой системы на кристалле островного типа // Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем (МЭС). 2020. Выпуск З. С. 16-21.
- 2. Hauck S., Denon A. Reconfigurable Computing: The Theory and Practice of FPGA-Based Computation. Morgan Kaufmann, 2008. 944 p.
- Farooq U., Parvez H., Marrakchi, Z. Exploration of Heterogeneous FPGA Architectures // Hindawi Publishing Corporation International Journal of Reconfigurable Computing, 18 p.
- Тельпухов Д.В., Рухлов В.С., Иванова Г. А., Рыжова Д.И., Надоленко В.В., Деменева А.И. Исследование вариантов частичного резервирования при проектировании сбоеустойчивых логических блоков ПЛИС// Инженерный вестник Дона, 2018, №1. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2018/4681 (дата обращения: 12.06.2023).
- Ristimaki T., Nurmi J. Reconfigurable IP blocks: a survey // 2004 International Symposium on System-on-Chip. 2004, pp. 117 – 122.
- Гаврилов С.В., Хватов В.М. Преимущества специализированных ресурсов программируемых логических интегральных схем для гибких сложно-функциональных блоков // Инженерный вестник Дона, 2021, №5. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n5y2021/6997 (дата обращения: 29.05.2023).



- Intel Quartus Prime Standard Edition User Guide Getting Started // Intel Corporation. URL: intel.com/content/dam/alteraglobal/en\_US/pdfs/literature/ug/ug-qps-getting-started.pdf (дата обращения: 15.09.2021).
- Xilinx Vivado Design Suite User's Guide // URL: docs.xilinx.com/viewer/book-attachment/pYmnSeekkH6djEKjge4YUQ/ InhHg5Xz61ZW6cwJAZZFhQ (дата обращения: 04.04.2023).
- Koch A. Structured Design Implementation A Strategy for Implementing Regular Datapaths on FPGAs // Fourth International ACM Symposium on Field-Programmable Gate Arrays. 1996. pp. 151-157.
- Kafafi N., Bozman K., Wilton S. Architectures and Algorithms for Synthesizable Embedded Programmable Logic Cores // Proceedings of the 2003 ACM/SIGDA Eleventh International Symposium on Field Programmable Gate Arrays (FPGA '03), 2003, pp. 3-11.
- Эннс В. И., Гаврилов С. В., Хватов В. М., Курбатов В. Г. Проектирование ПЛИС и реконфигурируемых СнК с использованием методов программного анализа и прототипирования // Микроэлектроника. 2021. Т. 50, № 6. С. 467-480.
- 12. Иванников А.Д., Стемпковский А.Л. Математическая модель цифровых блоков для системы совместного моделирования технических средств и программно-микропрограммного обеспечения // Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем (МЭС). 2021. Выпуск 1. С. 2-8.

# References

- 1. Zapletina M.A., Zheleznikov D.A., Gavrilov S.V. Problemy razrabotki perspektivnyh mikro- i nanoelektronnyh sistem (MES), 2020, № 3, pp. 16-21.
- Hauck S., Denon A. Reconfigurable Computing: The Theory and Practice of FPGA-Based Computation, Morgan Kaufmann, 2008. 944 p.



- Farooq U., Parvez H., Marrakchi Z. Exploration of Heterogeneous FPGA Architectures, Hindawi Publishing Corporation International Journal of Reconfigurable Computing, 18 p.
- Tel'pukhov D.V., Rukhlov V.S., Ivanova G. A., Ryzhova D.I., Nadolenko V.V, Demeneva A.I. Inzhenernyj vestnik Dona, 2018, №1. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2018/4681 (accessed 12 June 2023).
- Ristimaki T., Nurmi J. Reconfigurable IP blocks: a survey, 2004 International Symposium on System-on-Chip, 2004, pp. 117 – 122.
- Gavrilov S.V., Khvatov V.M. Inzhenernyj vestnik Dona, 2021, №5. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n5y2021/6997 (accessed 29 May 2023).
- Intel Quartus Prime Standard Edition User Guide Getting Started. URL: intel.com/content/dam/altera-/global/en\_US/pdfs/literature/ug/ug-qps-gettingstarted.pdf (accessed 15 September 2021)
- Xilinx Vivado Design Suite User's Guide. URL: docs.xilinx.com/viewer/book-attachment/pYmnSeekkH6djEKjge4YUQ/ InhHg5Xz61ZW6cwJAZZFhQ (accessed 04 April 2023).
- Koch A. Structured Design Implementation A Strategy for Implementing Regular Datapaths on FPGAs, Fourth International ACM Symposium on Field-Programmable Gate Arrays, 1996. pp. 151-157.
- Kafafi N., Bozman K., Wilton S. Architectures and Algorithms for Synthesizable Embedded Programmable Logic Cores, Proceedings of the 2003 ACM/SIGDA Eleventh International Symposium on Field Programmable Gate Arrays (FPGA '03), 2003. pp. 3-11
- 11. Enns V.I., Gavrilov S.V., Khvatov V.M., Kurbatov V.G. Mikroelektronika, 2021, T. 50, № 6, pp. 467-480.
- 12. Ivannikov D.A., Stempkovsky A. L. Problemy razrabotki perspektivnyh mikroi nanoelektronnyh sistem (MES), 2021. № 1. pp. 2-8.